

**Electronic component such as an SAW device and method for producing the same**

Patent Number: ☐ [US6498422](#)  
Publication date: 2002-12-24  
Inventor(s): HORI YOSHITSUGU (JP)  
Applicant(s): MURATA MANUFACTURING CO (JP)  
Requested Patent: ☐ [JP2000077970](#)  
Application Number: US19990387984 19990901  
Priority Number(s): JP19980248258 19980902  
IPC Classification: H03H9/25  
EC Classification: [H03H3/08](#), [H03H9/145](#)  
Equivalents: ☐ [DE19941872](#), [JP3303791B2](#)

---

**Abstract**

---

An electronic component comprises a substrate having a surface on which an electrode is formed and an SAW circuit element having a surface on which a circuit is formed. The circuit element is held such that the surface of the circuit element and the surface of the substrate are opposed to each other. A bump electrode joins the circuit on the circuit element and the electrode of the substrate together, and a sealing material joins the circuit element and the substrate together in the periphery of the space between the circuit-forming surface of the circuit element and the substrate. The space between the circuit-forming surface of the circuit element and the substrate is hermetically sealed by the circuit element, the substrate, and the sealing material. Advantageously, a low-temperature soldering material such as solder, or an adhesive, is used as the sealing material

---

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開 2000-77970

(P 2000-77970A)

(43) 公開日 平成12年3月14日 (2000. 3. 14)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード* (参考),
H 0 3 H	9/25	H 0 3 H	9/25 A 5J097
H 0 1 L	41/09		9/02 K 5J108
H 0 3 H	9/02		9/10
	9/10	H 0 1 L	41/08 C

審査請求 未請求 請求項の数 6

O L

(全 9 頁)

(21) 出願番号 特願平10-248258

(22) 出願日 平成10年9月2日 (1998. 9. 2)

(71) 出願人 000006231

株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

(72) 発明者 堀 良嗣

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式  
会社村田製作所内

(74) 代理人 100094019

弁理士 中野 雅房

F ターム(参考) 5J097 AA17 AA27 AA29 AA30 AA31

AA33 HA04 HA09 JJ03 JJ06

JJ07 JJ09 KK09 KK10

5J108 EE03 EE04 EE07 EE17 EE19

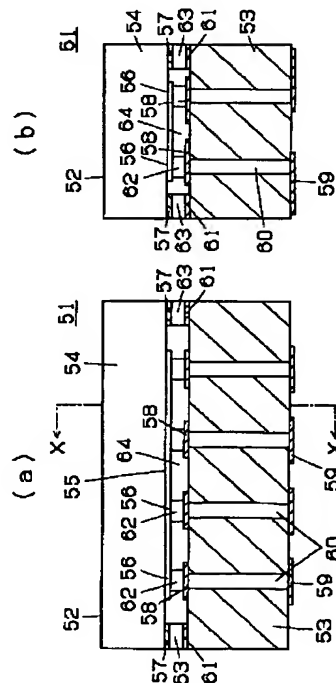
KK07

(54) 【発明の名称】 電子部品及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 簡単な構造によって小形の封止型電子部品を製作すると共に当該電子部品の電気的特性を良好にする。また、不良品を発生させないように歩留りよく電子部品を製造する。

【解決手段】 弾性表面波素子 5 2 の表面には、すだれ状電極 5 5 の入出力電極 5 6 と素子側シールリング 5 7 を設ける。マウント基板 5 3 の上面には、内側取り出し電極 5 8 と基板側シールリング 6 1 を設け、内側取り出し電極 5 8 の上に突起電極 6 2 を設け、基板側シールリングの上にはんだ等の封止材 6 3 を設ける。接合前には、突起電極 6 2 の高さは封止材 6 3 よりも高くなっている。しかして、弾性表面波素子 5 2 を上下反転してマウント基板 5 3 の上におき、突起電極 6 2 を入出力電極 5 6 に接触させる。ついで、突起電極 6 2 を加熱加圧して入出力電極 5 6 に接合させると同時に、封止材 6 3 を素子側シールリング 5 7 に接合させる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 回路素子の回路を形成された面と基板とを対向させ、回路素子に形成された回路と基板の電極とを突起電極によって接合し、回路素子の回路形成面と基板との間の空間の周囲において回路素子と基板を封止材によって接合し、回路素子、基板及び封止材によって回路素子の回路形成面と基板の間の空間を気密的に封止したことを特徴とする電子部品。

【請求項 2】 前記封止材は、はんだ等のろう材又は接着剤であることを特徴とする、請求項 1 に記載の電子部品。

【請求項 3】 前記回路素子の寸法と前記基板の寸法とがほぼ同じであることを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載の電子部品。

【請求項 4】 前記突起電極が Au を主成分とすることを特徴とする、請求項 1 ～ 3 に記載の電子部品。

【請求項 5】 回路素子に形成された回路と基板に設けられた電極のうちいずれか一方に突起電極を設け、回路素子に形成された回路の周囲を囲むようにして回路素子の回路を形成された面と基板のうちいずれか一方に前記突起電極よりも低い封止材を周設し、回路素子の回路を形成された面を基板に対向させて回路素子の回路と基板の電極を突起電極を介して接触させることにより、基板の電極を介して回路素子の回路を接地させ、突起電極に圧力を加えて突起電極により回路素子の回路と基板の電極を接続すると共に封止材によって回路素子と基板の間の空間の周囲を気密的に封止することを特徴とする電子部品の製造方法。

【請求項 6】 複数個分のサイズを有する基板に複数個の回路素子を接合一体化させた後、複数個の回路素子を実装された基板を 1 個ずつの電子部品に分離することを特徴とする、請求項 4 に記載の電子部品の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は電子部品及びその製造方法に関する。特に、本発明は、弾性表面波装置（SAW デバイス）や高周波デバイス、あるいはそれらを実装するモジュールやサブモジュール等の電子部品とその製造方法に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】（第 1 の従来例）従来の弾性表面波装置 1 の構造を図 1 に示す。この弾性表面波装置 1 にあっては、窪みを形成されたキャビティ構造のセラミックパッケージ 2 内に弾性表面波素子（チップ）3 を納めてダイボンドし、さらにワイヤ 4 によってセラミックパッケージ 2 に設けた電極部 5 に弾性表面波素子 3 をワイヤボンディングした後、セラミックパッケージ 2 の天面を板状のキャップ 6 で覆い、キャップ 6 の外周部をコバール（Kovar）リング 7 を介してセラミックパッケージ 2 の上面に溶接することにより、弾性表面波素子 3 を気

密封止している。

【0003】このような弾性表面波装置 1 では、弾性表面波素子 3 の電極材料として水分に弱い A1 等の電極材料が用いられるので、弾性表面波素子 3 を気密封止することにより、電極の腐食を防止している。また、弾性表面波素子 3 とキャップ 6 との間に空間を形成することにより、弾性表面波素子 3 の弾性振動を妨げないようにしている。

【0004】しかしながら、このような弾性表面波装置 1 では、窪みを有するキャビティ構造のセラミックパッケージ 2 を必要とするので、コストが高くついていた。また、弾性表面波素子 3 のサイズに対してセラミックパッケージ 2 の容積分だけ実装面積や高さ（厚み）が増すことになり、弾性表面波装置 1 等の高密度実装化や、この弾性表面波装置 1 が組み込まれる機器を小形化する障害となっていた。さらに、セラミックパッケージ 2 を用いているので、セラミックパッケージ 2 そのものの製造工程やコバールリング 7 の製造工程に加え、セラミックパッケージ 2 とコバールリング 7 の接合工程、弾性表面波素子 3 のダイボンディング、コバールリング 7 とキャップ 6 の溶接工程などが必要となり、製造工程が複雑で高価なものとなっていた。

【0005】（第 2 の従来例）従来の別な構造の弾性表面波装置 1 1 の構造を図 2 に示す。この弾性表面波装置 1 1 では、配線基板 1 2 上に弾性表面波素子（ベアチップ）1 3 をフェースダウンでフリップチップ実装し、弾性表面波素子 1 3 の表面に設けたパンプ 1 4 を配線基板 1 2 上に設けた基板電極 1 5 に接合している。弾性表面波素子 1 3 と配線基板 1 2 の間の空間 1 6 は、パンプ 1 4 と基板電極 1 5 の腐食防止や熱応力差による接合部の破壊を防ぐために、封止樹脂 1 8 によって気密的に封止されている。また、配線基板 1 2 の上面に設けた樹脂流れ防止膜 1 9 によって硬化前における封止樹脂 1 8 の樹脂流れを防止している。

【0006】しかしながら、このような弾性表面波装置 1 1 では、配線基板 1 2 と弾性表面波素子 1 3 の間に充填される封止樹脂 1 8 の比誘電率が 3 ～ 4 程度あるため、その誘電特性により弾性表面波装置 1 1 の通過損失や反射特性等に少なからず影響が見られた。また、封止樹脂 1 8 を配線基板 1 2 と弾性表面波素子 1 3 の間に充填するのに時間が掛かるため、製造工程を合理化する上での障害となっていた。また、弾性表面波素子 1 3 の表面を樹脂封止してしまうと、その機械的な弾性振動が抑制され、弾性表面波装置 1 1 の特性が悪くなる問題があった。

【0007】（第 3 の従来例）そこで、弾性表面波素子の弾性振動を阻害したり、通過損失等を悪くする封止樹脂を用いることなく、しかも小形化することができるものとして、キャビティ構造のセラミックパッケージとパンプ接続を用いた弾性表面波装置 2 1 が用いられてい

る。このような弾性表面波装置21を図3に示す。この弾性表面波装置21にあっては、図1で説明したようなセラミックパッケージ22内に弾性表面波素子23をフェースダウンで納め、弾性表面波素子23の上面に設けられたパンプ27を電極部24に接合し、セラミックパッケージ22の上にコパールリング25を介してキャップ26の外周下面を接合している。

【0008】このような構造の弾性表面波装置21では、弾性表面波素子23の表面を樹脂封止しないので、弾性表面波素子23の表面振動が阻害される恐れがなく、また封止樹脂によって弾性表面波装置21の通過特性や反射特性等を悪くすることもない。さらに、セラミックパッケージ22を用いているものの、パンプ接合することによってワイヤをボンディングするためのスペースを不要にしてセラミックパッケージ22の小形化を図っている。

【0009】しかしながら、このような弾性表面波装置21では、パンプ接合によってセラミックパッケージ22と弾性表面波素子23を一体化しているものの、セラミックパッケージ22を用いる点では第1の従来例と変りなく、第1の従来例と比較して格段に弾性表面波装置21を小型化できるものではなかった。

【0010】(第4の従来例)そこで、セラミックパッケージを用いることなく、しかも封止樹脂によって弾性表面波素子表面の弾性振動を阻害したりすることがなく、従って小形化が可能で、かつ信頼性の高い弾性表面波装置31として、図4に示すような構造のものが提案されている(特開平9-162690号公報)。この弾性表面波装置31にあっては、弾性表面波素子32の表面にすだれ状電極(図示せず)と入出力電極33が設けられており、入出力電極33の上にパンプ34が形成されている。また、その周囲には素子側シールリング35を周設している。そして、この弾性表面波素子32をフェースダウンにしてマウント基板36上に置き、マウント基板36に設けた取り出し電極37にパンプ34を接続すると共に素子側シールリング35をマウント基板36の基板側シールリング38に接合している。弾性表面波素子32の表面とマウント基板36との間の空間39は、素子側シールリング35と基板側シールリング38の接合によって封止しており、さらに弾性表面波素子32の裏面側から封止樹脂40を塗布して封止樹脂40内に弾性表面波素子32を封入し、封止樹脂40によって弾性表面波素子32とマウント基板36との間の空間39を封止している。

【0011】この弾性表面波装置31では、弾性表面波素子32の全体に液状の封止樹脂40を塗布し硬化させることにより弾性表面波素子32を封止している。このような封止樹脂40としては、従来のモールド樹脂に揮発性溶剤を加えたものが用いられており(上記公開公報に開示されている実施例では、住友ベークライト製のC

RPシリーズが用いられている)、このような封止樹脂40は絶縁性である。ところが、弾性表面波装置は、一般に、高周波になるほど電磁放射に対する対策が必要になり、この弾性表面波装置31のように絶縁性の封止樹脂で覆われていると、100MHz以上の高周波で用いたときに電磁輻射の影響を受けて誤動作する恐れが強い。

【0012】また、この弾性表面波装置31では、表面が封止樹脂で覆われていて湾曲しているので、チップマウントで弾性表面波装置31を自動挿入する際、チップマウントによる吸引状態が安定でなく、実装不良が多発する恐れがあった。

【0013】また、このような弾性表面波装置31では、素子側及び基板側シールリング35、38の材料としてAuを用い、素子側シールリング35と基板側シールリング38を仮圧着した後、両者をリフローさせて接合一体化している。ところが、Auからなる素子側シールリング35と基板側シールリング38を仮圧着させるためには、およそ250~400℃で加熱する必要がある。このとき、弾性表面波素子32に焦電性の強い材料(LiTaO<sub>3</sub>やLiNbO<sub>3</sub>)を使っている場合には、この加熱により弾性表面波素子32に焦電破壊を生じる恐れが高かった。そして、焦電破壊を生じると弾性表面波素子32としての特性に悪影響を与える問題があった。

【0014】さらに、弾性表面波素子32とマウント基板36の間の気密性を確保するため、基板側シールリング38と素子側シールリング35とを仮圧着させた後リフローさせているが、Auの融点は約1000℃であるため、リフロー加熱する際には、基板側シールリング38及び素子側シールリング35を約1000℃以上に昇温させなければならない。弾性表面波装置31では、一般に配線材料としてAlが使用されており、その融点は約660℃であるため、リフロー加熱の熱でAl配線が溶けてしまう。こうしてAl配線が切断すると、期待される電気特性が全く得られず、弾性表面波装置31は不良品となる。

#### 【0015】

【発明が解決しようとする課題】本発明は上述の技術的問題点を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、簡単な構造によって小形の封止型電子部品を製作すると共に当該電子部品の電気的特性を良好にすることにある。また、不良品を発生させないように歩留りよく電子部品を製造することができる電子部品の製造方法を提供することにある。

#### 【0016】

【発明の開示】請求項1に記載した電子部品は、回路素子の回路を形成された面と基板とを対向させ、回路素子に形成された回路と基板の電極とを突起電極によって接合し、回路素子の回路形成面と基板との間の空間の周囲

において回路素子と基板を封止材によって接合し、回路素子、基板及び封止材によって回路素子の回路形成面と基板の間の空間を気密的に封止したことを特徴としている。

【0017】この電子部品にあつては、回路素子と基板をパッケージとして用い、突起電極によって回路素子と基板との間に空間を形成し、回路素子、基板及び周囲の封止材によって回路素子と基板の間の空間を封止している。従つて、セラミックパッケージが不要で、電子部品を小形化し、低コスト化することができる。さらに、回路素子の上を封止樹脂によって覆っていないので、表面を平滑にすることができ、チップマウンタ等の自動実装機で電子部品を実装する場合にも実装ミスが生じにくい。

【0018】また、請求項2に記載しているように、封止材としてはんだ等のろう材や接着剤を用いれば、比較的低温で回路素子と基板を接合させることができるので、回路素子が熱によって破損される恐れがなく、製造時の不良品発生率を低減することができる。また、封止材としてはんだ等のろう材や接着材を用いれば、回路素子の上を封止樹脂で覆っていないくても、確実に回路素子と基板の間の空間を気密的に封止することができる。

【0019】さらに、請求項3に記載の実施態様は、請求項1又は2に記載した電子部品において、前記回路素子の寸法と前記基板の寸法とがほぼ同じであることを特徴としている。

【0020】このような構造の電子部品によれば、基板サイズを最小にして電子部品を小形化することができ、微小サイズの電子部品を形成することができる。

【0021】さらに、請求項4に記載の実施態様は、請求項1、2又は3に記載した電子部品において、前期突起電極がAuを主成分としていることを特徴としている。

【0022】Auを主成分とする突起電極を用いれば、接合を容易に行なえと共に接合部の抵抗を小さくできる。

【0023】請求項5に記載した電子部品の製造方法は、回路素子に形成された回路と基板に設けられた電極のうちいずれか一方に突起電極を設け、回路素子に形成された回路の周囲を囲むようにして回路素子の回路を形成された面と基板のうちいずれか一方に前記突起電極よりも低い封止材を周設し、回路素子の回路を形成された面を基板に対向させて回路素子の回路と基板の電極を突起電極を介して接触させることにより、基板の電極を介して回路素子の回路を接地させ、突起電極に圧力を加えて突起電極により回路素子の回路と基板の電極を接続すると共に封止材によって回路素子と基板の間の空間の周囲を気密的に封止することを特徴としている。

【0024】このようにして電子部品を製造すれば、突起電極を介して回路素子の回路と基板の回路を接触させ

ることによって回路素子の回路を接地しているので、回路素子と基板を接合させる際に回路素子に発生した焦電荷を突起電極を介して基板側からグランドへ逃がすことができ、回路素子の焦電破壊を防止することができる。

【0025】また、突起電極と封止材を同時に溶着させて回路素子と基板を接合しているのので、電子部品の製造工程を簡略化でき、製造効率を向上させることができる。

【0026】請求項6に記載の実施態様にあつては、請求項5に記載した電子部品の製造方法において、複数個分のサイズを有する基板に複数個の回路素子を接合一体化させた後、複数個の回路素子を実装された基板を1個ずつの電子部品に分離することを特徴としている。

【0027】この実施態様にあつては、複数個の電子部品を一度に製造することができるので、電子部品の製造効率を向上させることができる。

【0028】

【発明の実施の形態】（第1の実施形態）図5（a）

（b）は本発明の一実施形態による弾性表面波装置51の構造を示す断面図である。52は弾性表面波素子であつて、マウント基板53上にフェースダウンで実装されている。弾性表面波素子52は、水晶やLiTaO<sub>3</sub>、LiNbO<sub>3</sub>等からなる圧電基板54の表面にA1等からなる2組のすだれ状電極（IDT電極）55が形成され、各すだれ状電極55には入出力電極56が設けられている。また、圧電基板54の表面の外周縁には、全周にわたって素子側シールリング57が設けられている。

【0029】マウント基板53は、弾性表面波素子52とほぼ等しい縦横寸法を有している。マウント基板53の上面及び下面には、互いに対向するようにして内側取り出し電極58と外部電極59が設けられており、両電極58、59はマウント基板53を表裏に貫通するように設けられたスルーホール60によって導通させられている。さらに、マウント基板53の上面外周部には、基板側シールリング61が全周にわたって設けられている。

【0030】しかし、弾性表面波素子52は、フェースダウンでマウント基板53上に置かれ、入出力電極56をAuバンプのようなAuを主成分とする突起電極62によりマウント基板53の内側取り出し電極58に接合されている。また、素子側シールリング57と基板側シールリング61とは、封止材63によって接合されており、素子側シールリング57と基板側シールリング61を封止材63で接合することにより弾性表面波素子52の内面（すだれ状電極55が設けられている面）とマウント基板53との間の空間64を気密的に封止している。ここで、封止材63としては、SnまたはPb等を主成分とするろう材が用いられており、例えばSn系はんだ、Pb系はんだ、各種Pbフリーのはんだ等を使用することができる。

【0031】このような構造の弾性表面波装置 5 1 によれば、第 1 の従来例や第 3 の従来例のようにセラミックパッケージを用いておらず、弾性表面波素子 5 2 とマウント基板 5 3 自体によって封止構造を形成しているの  
で、弾性表面波装置 5 1 の小形化、低背化を図ることができる。また、高価なセラミックパッケージを用いない  
ので、コストも安価にすることができる。また、弾性表面波素子 5 2 とマウント基板 5 3 を接続するのに突起電  
極 6 2 を用いているので、突起電極 6 2 の高さによって弾性表面波素子 5 2 とマウント基板 5 3 の間に弾性表面  
波素子 5 2 の弾性振動を抑制しないように空間 6 4 を確保することができる。さらに、ボンディング用のワイヤ  
を用いないので、ワイヤを配線するための空間が必要なく、一層弾性表面波装置 5 1 を小形化することができ  
る。

【0032】また、本発明の弾性表面波装置 5 1 にあっては、弾性表面波素子 5 2 とマウント基板 5 3 と封止材  
6 3 のみによってすだれ状電極 5 5 の納められている空間 6 4 を封止しているの、第 2 の従来例や第 4 の従来  
例のように封止樹脂が必要なく、弾性表面波装置 5 1 の特性を劣化させることがない。さらに、封止樹脂を用い  
ていないから、弾性表面波装置 5 1 の上面を平滑にすることができ、チップマウンタ等による部品実装も容易に  
行なうことができる。

【0033】さらに、この弾性表面波装置 5 1 では、表面を封止樹脂によって覆われておらず、表面が平坦にな  
っているの、チップマウンタ等によって容易に吸着することができ、確実に部品実装を行なえる。

【0034】次に、上記弾性表面波装置 5 1 の製造方法を図 6 及び図 7 により説明する。図 6 (a) に示すよう  
に、圧着ステージ 6 5 は接地してグランド電位に保持されており、圧着ステージ 6 5 上には、弾性表面波素子 5  
2 の複数枚分の寸法（面積）を有するマウント基板 5 3（集合基板）が載置され、所定位置に位置決めされてい  
る。このマウント基板 5 3 には複数本のスルーホール 6 0 が表裏に貫通し、スルーホール 6 0 の上端はマウント  
基板 5 3 の上面に形成された内側取り出し電極 5 8 に導通し、スルーホール 6 0 の下端はマウント基板 5 3 の下  
面に形成された外部電極 5 9 に導通しており、各内側取り出し電極 5 8 と各外部電極 5 9 がスルーホール 6 0 を  
介して 1 対 1 に導通している。各内側取り出し電極 5 8 の上面には、Au からなる突起電極 6 2 がワイヤーボン  
ディング技術（Au ワイヤーの融着させる方法）によって設けられている。また、マウント基板 5 3 の上面の、  
弾性表面波装置 5 1 の 1 個に相当する領域の外縁全周には、はんだ濡れ性の良好な金属材料からなる基板側シ  
ールリング 6 1 が設けられている。はんだ濡れ性の良好な金属材料としては、Ni 層の上に Au 層を積層した 2 層  
構造のものなどを用いることができる。この基板側シールリング 6 1 の上面全周には、はんだ等のろう材からな

る封止材 6 3 が盛られている。この封止材 6 3 は、例えば印刷法によって基板側シールリング 6 1 上にろう材ペ  
ーストを供給し、ろう材ペーストのみの状態でリフロー  
ソルダーリングした後で洗浄し、フラックス残渣を取り除  
いて形成される。接合前のマウント基板 5 3 では、各突  
起電極 6 2 の高さを封止材 6 3 の高さに比べて高くして  
いる。

【0035】一方、圧着ステージ 6 5 の上方に位置する熱圧着ツール 6 6 の下面には、表面にすだれ状電極 5 5  
や入出力電極 5 6 等を形成された複数枚の弾性表面波素子 5 2 が、表面を下にして位置決め状態で吸着されてい  
る。

【0036】こうして圧着ステージ 6 5 上に位置決めされたマウント基板 5 3 と、熱圧着ツール 6 6 の下面に保  
持された弾性表面波素子 5 2 とは、互いに対向するよう  
に配置され、位置合わせした後、図 6 (b) のように互  
いに重ね合わされる。このとき、突起電極 6 2 の高さが  
封止材 6 3 の高さよりも高くなっているの、熱圧着ツ  
ール 6 6 を下降させると、まず図 6 (b) のように突起  
電極 6 2 が弾性表面波素子 5 2 の入出力電極 5 6 に当たる。この状態で熱圧着ツール 6 6 を 250℃～400℃  
に加熱し、さらに圧力を加えて熱圧着ツール 6 6 を下降  
させると、熱圧着ツール 6 6 の熱及び圧力で、突起電極  
6 2 が押し潰され、それによって図 6 (c) に示すよう  
にマウント基板 5 3 の封止材 6 3 が弾性表面波素子 5 2  
の素子側シールリング 5 7 に接触する。このとき、熱圧  
着ツール 6 6 によって、はんだ等のろう材からなる封止  
材 6 3 が融ける程度の熱と圧力を弾性表面波素子 5 2 と  
マウント基板 5 3 に加え、熔融した封止材 6 3 の表面の  
酸化膜をその圧力で破り、各弾性表面波素子 5 2 の素子  
側シールリング 5 7 と接合させる。同時に、マウント基  
板 5 3 の突起電極 6 2 と弾性表面波素子 5 2 の入出力電  
極 5 6 も、熱圧着ツール 6 6 の熱によって拡散接合され  
る。このように封止材 6 3 の接合と突起電極 6 2 の接合  
を同時に行なうことができるので、工程数を短縮して簡  
略化することができる。

【0037】第 4 の従来例では、基板側シールリングと素子側シールリングを約 1000℃でリフローさせる必要  
があったが、本発明の場合には、はんだ等からなる封  
止材 6 3 を用いているので、250℃～400℃の加熱  
で弾性表面波素子 5 2 とマウント基板 5 3 を接合させて  
空間 6 4 を封止することができ、断線等による不良品の  
発生を防止することができる。

【0038】上記のように、接合前において、突起電極  
6 2 の高さを封止材 6 3 の高さよりも高くしているの  
で、弾性表面波素子 5 2 とマウント基板 5 3 とを接合す  
る際、封止材 6 3 で弾性表面波素子 5 2 とマウント基板  
5 3 とを接合する前に、確実に突起電極 6 2 を押し潰し  
て弾性表面波素子 5 2 の入出力電極 5 6 に接合させるこ  
とができる。

【0039】ところで、弾性表面波素子52は、前記のように焦電性を有しているため、温度変化があると表面に電荷（焦電荷）が蓄積する。これが原因となり、すだれ状電極55間で放電を生じ、すだれ状電極55が局所的に溶解し、特性不良の原因となることがある。この現象は焦電破壊と呼ばれ、焦電破壊が生じ易い材料としては、 $\text{LiTaO}_3$ や $\text{LiNbO}_3$ などが知られている。焦電破壊は、弾性表面波素子52から電荷が迅速に逃げるようにしてやれば、防ぐことができる。この弾性表面波装置51では、突起電極62の高さを封止材63よりも高く形成しておき、弾性表面波素子52とマウント基板53を一体化する時にまず突起電極62が入出力電極56と当接し、突起電極62を介して弾性表面波素子52の電荷がマウント基板53へ逃げる。金属製の圧着ステージ65はグラウンドに接地されており、圧着ステージ65上に載置されたマウント基板53は、外部電極59が圧着ステージ65に電気的に接触しているため、マウント基板53の突起電極62も内側取り出し電極58、スルーホール60、外部電極59及び圧着ステージ65を介して接地状態にある。このため、マウント基板53に逃げた電荷は、圧着ステージ65を通してグラウンドへ逃がされる。そして、突起電極62が弾性表面波素子52に当接してから接合のために温度を上げると、弾性表面波素子52に生じた電荷は、突起電極62、マウント基板53及び圧着ステージ65を介してグラウンドへ逃げるため、焦電性の高い圧電基板材料を用いている場合でも、焦電破壊を生じさせることなく、弾性表面波素子52とマウント基板53とを接合させることができる。

【0040】なお、図6(a)(b)では、マウント基板53に突起電極62を設けているが、弾性表面波素子52に突起電極62を設けてあっても差し支えない。ただし、弾性表面波素子52に突起電極62を設けると、ワイヤーボンディングなどの手法を用いる場合には、突起電極形成時にウエハを加熱することになるので、焦電破壊を生じる恐れがある。このため、マウント基板53に突起電極62を設ける方が歩留まりよく、弾性表面波装置51を製造できる。

【0041】こうして弾性表面波素子52とマウント基板53とを接合し終わると、図7(d)に示すように、熱圧着ツール66を圧着ステージ65上から退避させ、接合された弾性表面波装置51を冷却させ、また冷却時に発生する帯電電荷を圧着ステージ65からグラウンドへ逃がす。弾性表面波装置51が冷却したら、図7(e)に示すように、ダイシングによってマウント基板53

（集合基板）を1個1個の弾性表面波装置51に切り離し、図5に示したような弾性表面波装置51を同時に複数個製造する。弾性表面波装置51は1個ずつ製造してもよいが、この実施形態のように複数の弾性表面波装置51を同時に製造して分割することにより、効率よく弾性表面波装置51を製造することができる。

【0042】（第2の実施形態）図8(a)(b)

(c)は本発明の別な実施形態による弾性表面波装置71の構造及びその製造方法を説明する図である。この実施形態にあつては、プリント配線基板やセラミック基板等からなるマウント基板53は弾性表面波素子52よりも大きな面積を有しており、マウント基板53の上面の素子実装領域には基板側シールリング61と内側取り出し電極58が設けられており、基板側シールリング61上にははんだ等のろう材からなる封止材63が盛られており、図8には示されていないが圧着ステージと電気的に導通するように設けられた外部電極59に内側取り出し電極58が導通している。また、マウント基板53の素子実装領域以外の領域には、配線パターン72が形成されており、その上には所要の表面実装部品73がはんだ付け等により実装されている。

【0043】一方、弾性表面波素子52の表面には、すだれ状電極55の入出力電極56と素子側シールリング57が形成されており、入出力電極56には突起電極62が設けられている。この実施形態でも、突起電極62の高さは、封止材63の高さよりも高くなっている。

【0044】図8(a)に示すように、第1の実施形態の場合と同様にして、接地された圧着ステージ65の上に上記マウント基板53を載置し、弾性表面波素子52をフェースダウンにして熱圧着ツール66の下面に吸着させる。ついで、図8(b)に示すように、弾性表面波素子52をマウント基板53の上に実装し、突起電極62をマウント基板53の内側取り出し電極58に接触させる。この状態では、突起電極62は圧着ステージ65等を介して接地されており、弾性表面波素子52で生じた電荷はグラウンドへ逃がされる。このとき、封止材63は素子側シールリング57から離間している。

【0045】こうして突起電極62を内側取り出し電極58に接触させ、熱圧着ツール66と圧着ステージ65で弾性表面波素子52とマウント基板53を圧着させながら加熱し、図8(c)のように、突起電極62を内側取り出し電極58に接合させ、さらに封止材63を溶融させて素子側シールリング57に溶接させる。

【0046】この実施形態でも、セラミックパッケージ等のケースが必要ないので、弾性表面波装置の小型化や低背化を図れ、コストも安価にすることができる。しかも、はんだ等の封止材で弾性表面波素子とマウント基板の間の空間の周囲を封止することにより、弾性表面波素子52の気密性を確保することもできる。さらに、マウント基板53上に他の部品も実装することができるので、部品の実装密度を高くすることができ、各種回路の集積度を高めることができる。

【0047】（第3の実施形態）図9は本発明のさらに別な実施形態による弾性表面波装置76の構造を示す断面図である。この弾性表面波装置76にあつては、マウント基板53の外周を覆うように導電性被膜77を形成



し、弾性表面波素子 5 2 及び封止材 6 3 の外面を覆うように導電性被膜 7 8 を形成し、両導電性被膜 7 7、7 8 を互いに導通させてある。この導電性被膜 7 7、7 8 は、グランド用の外部電極 5 9 と導通しているが、それ以外の外部電極 5 9 からは絶縁している。

【0048】この実施形態によれば、絶縁性のマウント基板 5 3 を用いた場合でも、弾性表面波装置 7 6 に電磁放射ノイズ対策（シールド）を施すことができる。なお、導電性皮膜 7 7、7 8 は、導電性粒子を分散した樹脂シート、金属シートの成形品、導電性粒子を分散配合した樹脂成形品などで形成することができる。

【0049】（第 4 の実施形態）図 10 は本発明のさらに別な実施形態による弾性表面波装置 8 1 の構造を示す断面図である。この弾性表面波装置 8 1 も電磁シールド効果を有するものであるが、素子側の導電性被膜 7 8 は弾性表面波素子 5 2 の裏面にのみ設けられており、素子側の導電性被膜 7 8 は弾性表面波素子 5 2 に設けられたスルーホール 8 2 及び封止材 6 3 を介してマウント基板 5 3 の導電性被膜 7 7 に導通させられている。

【0050】よって、この実施形態でも、絶縁性のマウント基板 5 3 を用いた弾性表面波装置に電磁放射ノイズ対策（シールド）を施すことができる。

【0051】なお、上記各実施形態においては、突起電極を Au で、封止材をはんだ等のろう材で形成した場合を説明したが、突起電極及び封止材を同一の硬化条件を持つ導電性接着剤で形成してもよい。また、突起電極や封止材の接合方法としては、加熱に限らず、超音波や圧力、振動等によって接合してもよい。

#### 【図面の簡単な説明】

【図 1】従来の弾性表面波装置の構造を示す断面図である。

【図 2】従来の別な弾性表面波装置の構造を示す断面図

である。

【図 3】従来のさらに別な弾性表面波装置の構造を示す断面図である。

【図 4】従来のさらに別な弾性表面波装置の構造を示す断面図である。

【図 5】（a）は本発明の一実施形態による弾性表面波装置の断面図、（b）は（a）の X-X 線断面図である。

【図 6】（a）（b）は同上の弾性表面波装置の製造方法を説明する断面図である。

【図 7】（c）（d）（e）は図 6 の続図である。

【図 8】（a）（b）（c）は本発明の別な実施形態による弾性表面波装置の製造方法を説明する断面図である。

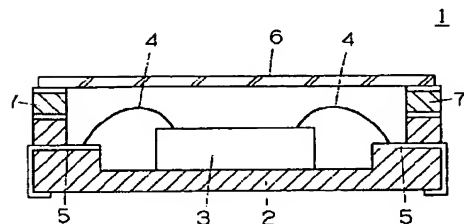
【図 9】本発明のさらに別な実施形態による弾性表面波装置を示す断面図である。

【図 10】本発明のさらに別な実施形態による弾性表面波装置を示す断面図である。

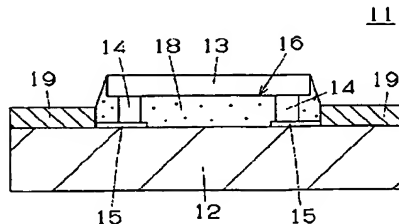
#### 【符号の説明】

- 5 2 弾性表面波素子
- 5 3 マウント基板
- 5 6 入出力電極
- 5 7 素子側シールリング
- 5 8 内側取り出し電極
- 6 1 基板側シールリング
- 6 2 突起電極
- 6 3 封止材
- 6 4 空間
- 6 5 圧着ステージ
- 6 6 熱圧着ツール
- 7 7、7 8 導電性被膜

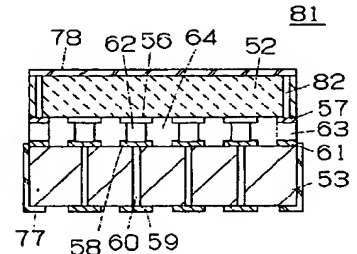
【図 1】



【図 2】

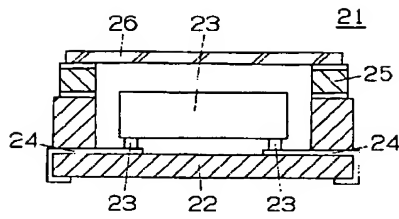


【図 10】

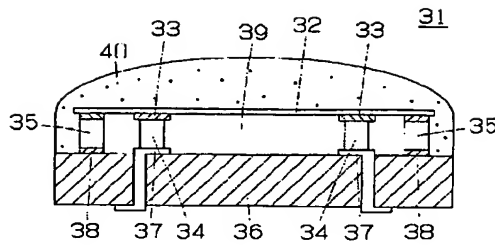




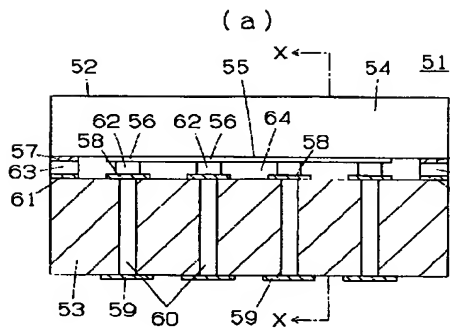
【図 3】



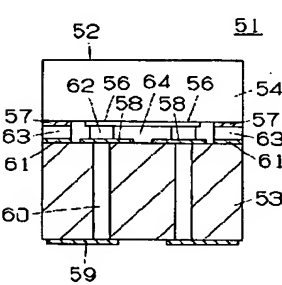
【図 4】



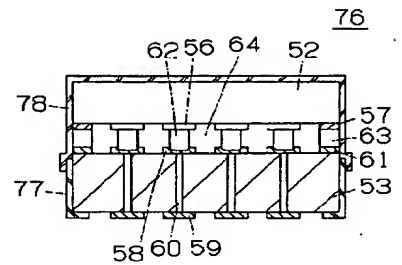
【図 5】



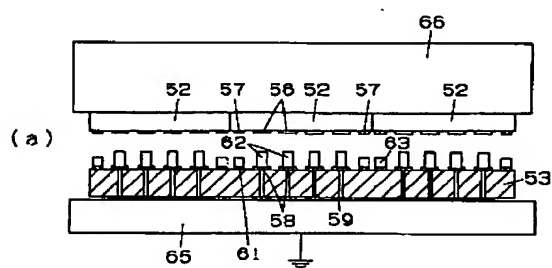
(b)



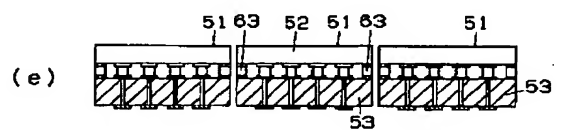
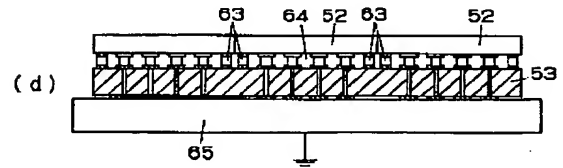
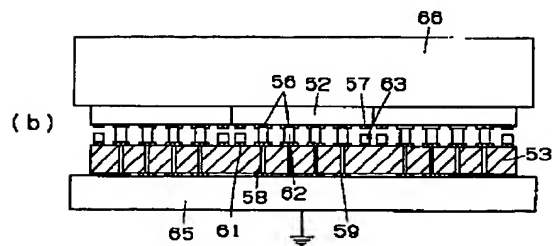
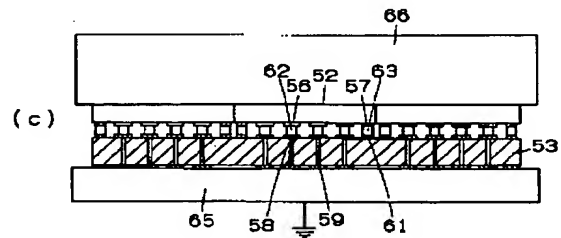
【図 9】



【図 6】



【図 7】



【図8】

